

onsemi 全桥的LLC方案

Orson Chen 应用技术处 友尚集团



- 1. 摘要
- 2. 简介
- 3. 全桥LLC谐振式转换器电路动作原理
- 4. 转换器参数设计和输出寄生电容对效率的影响
- 5. 实测结果
- 6. 结论





- 使用半桥LLC谐振式控制芯片完成全桥LLC谐振式转换器 的制作;
- 分析初级侧功率晶体管的输出寄生电容对全桥LLC谐振式 转换器的效率影响,并予以优化。



简介



1. 使用半桥LLC谐振式控制芯片去控制第一臂功率晶体管;

2. 使用耦合变压器输出反向讯号以驱动第二臂功率晶体管。

高转换效率

1. 使用同步整流技术控制次级侧开关;

2.调整第一臂功率开关的输出寄生电容,以平衡双臂开关动作不 一致所造成的效率影响。



半桥与全桥优缺点比较

半桥LLC谐振式转换器	全桥LLC谐振式转换器
功率晶体管 × 2	功率晶体管 × 4
谐振槽参考点:+V _{in} 和 0	谐振槽参考点:+V _{in} 和-V _{in}
控制方式较为简易	控制方式较为困难
应用于小功率	应用于大功率
市面较多为半桥LLC控制芯片	市面目前还未有全桥LLC控制芯片



全桥LLC谐振式转换器动作原理



零电压切换(ZVS)

- LLC谐振式转换器最大的一项特性就是在全负载范围下都 可以达到零电压切换(ZVS)状态;
- 2. 使用ZVS可降低切换损失(Switching Loss);
- 3. LLC谐振式转换器是利用死区时间,加上转换器处于电感性操作下达到ZVS状态。



纯L与纯C转换器

操作频率易受到负载变化的影响



(b) 200 $R_{lpad} = 200 \Omega$ $R_{lpad} = 150 \Omega$ $R_{load} = 100 \Omega$ $R_{load} = 80 \Omega$ $R_{load} = 80 \Omega$

图1 纯L转换器及不同输入频率、不同负载下输出仿真结果

转换器增益易受到负载变化的影响



图2 纯C转换器及不同输入频率、 不同负载下输出仿真结果

LC谐振式转换器

此转换器具有上述两种转换器的优缺点



图3 LC谐振式转换器 及不同输入频率、不 同负载下输出仿真结 果



LLC谐振式转换器

 v_{in}

 C_r

 L_r

- 1. 负载变化下操作频率较不会出现剧烈的变化;
- 2. 转换器增益增加在设计上有更多弹性。





 v_{out}

 R_{load}

 L_m

图4 LLC谐振式转 换器及不同输入频 率、不同负载下输 出仿真结果



LLC谐振式转换器

- 1. Region 1:转换器位于电感性区,功率晶体管皆工作于ZVS状态;
- 2. Region 2:转换器处于电阻性区,功率晶体管维持工作于ZVS状态;
- 3. Region 3:转换器位于电容性区, 二极管工作于零电流切换(ZCS)状态。





LLC谐振式转换器

初级侧为全桥电路与LLC谐振槽,次级侧为全波整流电路。



工作状态波形

四颗功率晶体管的动作、谐振槽的电流状况与输出二极管电流的波形。



工作原理(模式ー・ $t_0 \leq \mathbf{t} < t_1$)





 \dot{t}_A \dot{t}_5 \dot{t}_6

t2 t2

工作原理(模式二 $t_1 \leq \mathbf{t} < t_2$)





 t_{4} t_{5} t_{6}

工作原理(模式三・ $t_2 \leq \mathbf{t} < t_3$)





 t_{4} t_{5} t_{6}

工作原理(模式四・ $t_3 \leq \mathbf{t} < t_4$)



i_{Dr1}/i_{Dr2}

 t_1 t_2

17



工作原理(模式五・ $t_4 \leq \mathbf{t} < t_5$)



图12 全桥LLC谐振式转换器模式五等效电路($t_4 \le t < t_5$)



 $t_1 \ t_2 \ t_3$

iDr1/iDr2

工作原理(模式六・ $t_5 \leq \mathbf{t} < t_6$)



图13 全桥LLC谐振式转换器模式六等效电路($t_5 \leq t < t_6$)



 $t_1 \ t_2 \ t_3$

iDr1/iDr2

输出寄生电容对转换器效率分析



谐振槽参数设计

半桥与全桥架构差别在转换器的输入状态由0至V_{in}变为+V_{in}至-V_{in},故 计算采用半桥LLC谐振槽方式并以两倍输入电压进行计算。

参数名称/组件名称	规格/型号
输入电压范围(V _{in})	350 <i>VDC</i> ~ 420 <i>VDC</i>
输出电压(V _{out})	48 <i>VDC</i>
满载额定功率(Pout)	1800W
谐振频率(<i>f_r</i>)	82kHz
转换器初级侧功率晶体管	STF13N80K5
转换器次级侧整流二极管	P10L150SP

表1 规格及元器件料号



变压器匝比

为了让转换器都保持在最佳转换效率,选择当输入电压额定时,转换器 增益为1。

$$G_{(nom)} = \frac{n(V_{out} + V_{Dr})}{2DV_{in(nom)}} = 1$$
(1)

$$n = \frac{2DV_{in(nom)}G_{(nom)}}{(V_{out} + V_{Dr})} = \frac{2 \times 400 \times 0.5 \times 1}{(48 + 2 \times 0.66)} = 8.11$$
(2)
其中



次级侧整流二极管的顺向导通电压。

转换器增益范围

由(1)式将额定输入电压设定为最大或最小的输入电压,得到该转换器的 增益范围:

 $G_{(min)} = \frac{n(V_{out} + V_{Dr})}{2DV_{in(max)}} = \frac{8.11 \times (48 + 2 \times 0.66)}{0.5 \times 2 \times 420} = 0.952$ (3) $G_{(max)} = \frac{n(V_{out} + V_{Dr})}{2DV_{in(min)}} = \frac{8.11 \times (48 + 2 \times 0.66)}{0.5 \times 2 \times 350} = 1.143$ (4) 其中 $G_{(min)} : 转换器的最小增益;$ $G_{(max)} : 转换器的最大增益;$





不同的质量因素会得到相对应的转换器增益。

$$Q = \frac{0.95}{KG_{(max)}} \times \sqrt{K + \frac{G_{(max)^2}}{G_{(max)^2 - 1}}} = \frac{0.95}{8.6 \times 1.143} \times \sqrt{8.6 + \frac{1.143^2}{1.143^2 - 1}} = 0.328$$
(5)



初级侧的等效电阻

求出满载下反射至初级侧的等效电阻:

$$R_{load} = \frac{V_{out}^2}{P_{out}} = \frac{48^2}{1800} = 1.28\Omega$$
(6)

$$R_p = 8\frac{n^2 R_o}{\pi^2} = 8 \times 8.11^2 \times \frac{1.28}{\pi^2} = 68.24\Omega \tag{7}$$

$$R_p$$
:满载下负载反射至初级侧的电阻。



其中

谐振电容

$$C_r = \frac{1}{2\pi f_r Q R_p} = \frac{1}{2 \times \pi \times 82000 \times 0.328 \times 68.24} = 86.715 nF$$
(8)

$$Q_{(fix)} = \frac{1}{2\pi f_r R_p C_r} = \frac{1}{2 \times \pi \times 82000 \times 68.24 \times 99 \times 10^{-9}} = 0.287$$
(9)

其中
$$Q_{(fix)}$$
:修正后的质量因素。

根据(8)式得到理想上谐振电容值为86.715*nF*,依据实际状况选择谐振电容值为99*nF*。



谐振电感、激磁电感

$$L_r = \frac{Q_{(fix)}R_p}{2\pi f_r} = \frac{0.287 \times 68.24}{2 \times \pi \times 82000} = 38uH$$
(10)

$$L_m = KL_r = 8.6 \times 35 \times 10^{-6} = 300uH \tag{11}$$

可得 C_r 为99 $nF \cdot L_r$ 为35uH与 L_m 为300 $uH \circ$



变压器匝数

为制作大功率转换器,本案采用两颗变压器并联输出,选用 PC47PQ40/40铁芯。

表2 PC47PQ40/40铁芯之规格

铁芯	磁通密度 100℃	铁芯有效长度	铁芯有效面积	铁芯有效体积
PQ40/40	4800Gauss	102mm	201mm ²	20500mm ³



变压器匝数

$$N_{P} = \frac{V_{in(nom)}D \times 10^{8}}{4A_{e}f_{r}B_{max}} = \frac{400 \times 0.5 \times 10^{8}}{4 \times 201 \times 10^{-3} \times 2400 \times 82000} = 126.4Turn$$
(12)
$$N_{S} = N_{P}\frac{1}{n} = 126.4 \times \frac{1}{8.11} = 15.585Turn$$
(13)

$$A_e$$
:铁芯有效面积。

选定*N_P*为126匝、*N_S*为16匝。



谐振电感匝数

为制作大功率转换器,本案采用谐振电感独立存在,铁芯选用 PC47PQ26/20。

表3 PQ26/20铁芯之规格

铁芯	感应系数	铁芯有效长度	铁芯有效面积	铁芯有效体积
PQ26/20	6170nH/N ²	46.3mm	119mm ²	5490mm ³



谐振电感匝数

$$N_r = \sqrt{\frac{L_r}{A_L}} = \sqrt{\frac{35 \times 10^{-6}}{6170 \times 10^{-9}}} = 2.382Turn$$

 N_r :谐振电感匝数。

本案选择Nr为3匝。



(14)

输出电容设计

$$T_{(min)} = \frac{1}{f_r} (1 - D) = \frac{1}{82000} \times (1 - 0.5) = 6.098 uS$$
(15)

$$V_{out(ripple)} = 0.002V_{out} = 0.002 \times 48 = 0.0096V$$
(16)

$$C_{out} \ge \frac{37.5 \times 6.098 \times 10^{-6}}{0.0096} \ge 2382 uF \tag{17}$$

为降低电压涟波, 故在转换器输出端加上电解电容, 本案选用**Nichicon** 所生产的560*uF*/100V电解电容五颗并联。



 C_{OSS} 对效率的影响

- **1.** dead time 过短将导致 C_{oss} 能量无法完全转移完毕造成切换损耗;
- 2. dead time过长将导致多于能量流经本体二极管造成导通损耗;
- 本案使用之半桥LLC谐振式控制芯片藉由侦测Coss能量是否释放完毕 调整dead time;
- 4. 重载下转换器功率损耗以变压器铁损和铜损为主。



Region 1模式二

Region 1(轻载)状态下,变压器依旧进行能量传递。





Region 1模式二

回路中转移的能量是固定的,每一个状态下只会有一对角输出寄生电容 充满电荷。





理想ZVS时间计算

输出寄生电容内的能量会等于谐振槽流动的能量。

$$(C_{oss1} / / C_{oss4}) V_{AB} = i_L t_{ZVS}$$
(18)

$$(C_{oss1} / / C_{oss4}) V_{in} = i_L t_{ZVS}$$
(19)

$$i_L = i_m + i_p$$
(20)

$$i_L = \frac{nV_0}{L_m} t_{ZVS^2} + \frac{I_0}{n} t_{ZVS}$$
(21)
其中

$$V_{AB} : 谐振槽电压 ;
$$Q_{AB} : 总电荷量 ;$$

COSECTIVE TO THE TANK IN THE CONSTRUCT OF THE CONSTRUCT OF$$

理想ZVS时间计算

$$(C_{oss1} / / C_{oss4}) V_{in} = \frac{nV_o}{L_m} t_{ZVS^2} + \frac{I_o}{n} t_{ZVS}$$
(22)
$$\frac{nV_o}{L_m} t_{ZVS^2} + \frac{I_o}{n} t_{ZVS} - (C_{oss1} / / C_{oss4}) V_{in} = 0$$
(23)

$$t_{ZVS} = \frac{\frac{I_0}{n} + \sqrt{\left(\frac{I_0}{n}\right)^2 + 4\left(\frac{nV_0}{L_m}\right) \times (C_{oss1}//C_{oss4})V_{in}}}{2\frac{nV_0}{L_m}}$$
(24
当负载为300W情况下,理想 $t_{ZVS} = 1.2947ns$ 。



 C_{OSS} 计算

因控制芯片无法侦测第二臂功率晶体管*Coss*能量是否释放完毕;且耦合变压器回路造成双臂时间差;故需要更多时间让第二臂释放能量;本案采并联第一臂的输出寄生电容以延长dead time。



Coss计算

同一对输出寄生电容储能相同。

$$Q_{Coss1} = Q_{Coss4}$$

$$\frac{i_L}{V_{in}} t_{ZVS1} = \frac{i_L}{V_{in}} t_{ZVS2}$$

(26)

(25)

因为双臂功率晶体管存在时间差,导致第二臂功率晶体管无法于dead time时间内释放完所有能量,也代表需要更多时间让第二臂释放能量, $\Delta t_{ZVS1} < t_{ZVS2}$ 。



Coss计算

将
$$t_{ZVS2}$$
代入(23)式可得:

$$\frac{nV_o}{L_m}t_{ZVS2^2} + \frac{I_o}{n}t_{ZVS2} - (C_{oss,New})V_{in} = 0$$
(27)

$$C_{oss,New} = \frac{\frac{nV_o}{L_m}t_{ZVS2^2} + \frac{I_o}{n}t_{ZVS2}}{V_{in}}$$
(28)

$$C_{oss1} + C_{ossX} = C_{oss,New}$$
(29)

求得第二臂优化后得*C_{oss,New}*为82*pF*,再由(29)式可得第一臂功率晶体管 需并联32*pF*输出电容。



Dead time过长

继续增加*Coss*持续延长dead time,将导致第二臂*Coss*在能量转移完毕后剩余能量流经第二臂开关的本体二极管。





Dead time过长

$$P_{ZVS,Con} = i_L V_{D_{SD3}} \left(t_{ZVS,exc} - t_{ZVS,mod} \right)$$
(30)

其中

t_{ZVS,exc}:过长的ZVS时间; t_{ZVS,mod}:最佳的ZVS时间。

当第一臂 C_{oss} 增加超过32pF之后,每增加10pF,便会增加大约500pW的功率损失。







实体制作



图18 全桥LLC谐振式转换器实体制作



转换器架构图

全桥LLC谐振转换器结合次级侧同步整流。



转换器规格

表4转换器规格与数值

规格	数值
输入电压范围 (V _{in} Range)	$350V_{dc} \sim 420V_{dc}$
输出电压 (V _{out})	48 <i>V</i> _{dc}
满载谐振频率(<i>f</i> _r)	82kHz
谐振电容 (<i>C_r</i>)	99 <i>nF</i>
谐振电感 (<i>L_r</i>)	35µH
激磁电感 (<i>L_m</i>)	300µH
转换器初级侧LLC谐振式控制芯片	NCP13992
转换器初级侧驱动芯片	NCP5304
转换器次级侧同步整流控制芯片	NCP4318



操作频率

LLC谐振式转换器切换方式为脉波频率调变,因此转换器的操作频率会随着负载变化。





ZVS状态

本案使用半桥LLC谐振式控制芯片完成全桥LLC谐振式转换器,也导致两 臂dead time时间无法一<u>致</u>,因而无法达到初级侧功率晶体管皆进入ZVS



图22 全桥LLC谐振式转换器初级侧下桥功率晶体管ZVS状态

状态。



完成1200W的全桥LLC谐振式转换器,重载下转换效率平均为96%。



图23 全桥LLC谐振式转换器之转换效率



次谐波振荡

转换器制作中发现次谐波振荡现象,导致变压器发出极大噪音。



比流器回路

实际谐振槽电流与比流器取样电流具有相位差,导致最终进入控制器的 信号与实际有落差,经相移回路解决次谐波振荡。



onsemi YOSUN thi



ZVS修正

调整第一臂功率开关的输出寄生电容,达到双臂功率晶体管皆进入ZVS





状态。

图27 全桥LLC谐振式转换器调整第一臂Coss后之dead time

Dead time过多

调整第一臂输出寄生电容过多,导致第二臂出现导通损失。



修正后的转换效率

300W时效率由92.603%提升至93.462%。







结论

- 采用半桥LLC谐振式控制芯片完成全桥LLC谐振式转换器,在相同的输入电压下,能够输出更高的功率;
- 2. 使用控制芯片控制第一臂功率晶体管,并调整第一臂功率晶体管的Coss以延长转换器dead time,达到四颗功率晶体管进入ZVS状态,以提升转换器轻载效率;
- 实现1800W全桥LLC谐振式转换器,由实测结果可知转换器在
 300W输出下效率由92.603%提升至93.462%,转换器电路最高效



Reference

- 1. Ping Wang, Guodong Cui, Liuye Chen, "Analysis and Design of LLC with new Current Driven Synchronous Rectifiers", IEEE, 2011
- 2. onsemi, "FAN7688", datasheet, 2015
- 3. Rashid Ali, Adam Noora, Muhammad Mudassir Fareed, Zain-UI-Abdin Alias Faraz, Shahid Hussain Siyal, "Computational Analysis of PT/CT Contact Behavior for a Heavy Water Reactor at High Temperature and Pressure", IEEE, 2018
- 4. Yuequan Hu, Jianwen Shao, Teik Siang Ong, "6.6kW High-Frequency Full-Bridge LLC DC/DC Converter with Sic MOSFETs", IEEE, 2019
- 5. Fanghua Zhang, "Novel Forward–Flyback Hybrid Bidirectional DC–DC Converter", IEEE, 2009
- 6. XueZhe Wei, Xiaopeng Zhao, Dai Haifeng, "The application of flyback DC/DC converter in Li-ion batteries active balancing", IEEE, 2009
- Cheon-Yong Lim, Jung-Kyu Han, Moo-Hyun Park, Keon-Woo Kim, "Phase-Shifted Full-Bridge DC-DC Converter With High Efficiency and Reduced Output Filter Using Center-Tapped Clamp Circuit", IEEE, 2019
- 8. Subhendu Dutta, Dipten Maiti, Arindam K. Sil and Sujit K. Biswas, "A Soft-Switched Flyback Converter with Recovery of Stored Energy in Leakage Inductance", IEEE, 2012
- 9. Hai-Nam Vu, Dai-Duong Tran, Woojin Choi, "A Novel Hybrid Soft Switching Full-Bridge PWM and Full-Bridge LLC Converter for On-Board Battery Charger Applications", IEEE, 2016





为您提供在线技术服务体验

-键观看视频介绍: http://t.cn/AiYVB98S













THANK YOU

